

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【公開番号】特開2000-150678(P2000-150678A)

【公開日】平成12年5月30日(2000.5.30)

【出願番号】特願平10-319415

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/8247

H 01 L 29/788

H 01 L 29/792

H 01 L 21/28

H 01 L 21/3065

H 01 L 27/115

【F I】

H 01 L 29/78 3 7 1

H 01 L 21/28 F

H 01 L 21/302 J

H 01 L 27/10 4 3 4

【手続補正書】

【提出日】平成17年11月4日(2005.11.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項17

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項17】半導体基板の主表面に設けられた第1ゲート絶縁膜と、
その上に形成された第1ゲート電極と、
前記第1ゲート電極の上に第2ゲート絶縁膜を介して形成された第2ゲート電極と、
前記第2ゲート電極の側壁に形成された保護膜とを備えている不揮発性半導体記憶装置
。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項18

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項18】半導体基板の主表面に設けられた第1ゲート絶縁膜と、
その上に形成された第1ゲート電極と、
前記第1ゲート電極の上に第2ゲート絶縁膜を介して形成された第2ゲート電極と、
前記第1ゲート電極の側壁に接する絶縁膜と第1ゲート絶縁膜とが形成する段差側壁に、
多結晶シリコンが絶縁体化されたシリコン化合物とを有する不揮発性半導体記憶装置。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項19

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項19】半導体基板の上に、第1ゲート絶縁膜を介して第1ゲート層がエッ
チングされることにより形成された第1ゲート電極と、
その第1ゲート電極の上に、第2ゲート絶縁膜を介して第2ゲート層がエッ
チングされ

ることにより形成された第2ゲート電極とを備えた不揮発性半導体記憶装置であって、

前記第1ゲート電極の側壁が接する絶縁膜と前記第1ゲート絶縁膜とによって形成される角度が、前記第1ゲート電極の側壁に沿って延びる方向に直交する断面で、前記第1ゲート電極側に対して90°を超える、前記第1ゲート電極の側壁が接する絶縁膜の両側壁の各々には、前記第1ゲート電極の幅が上方ほど広くなるようにテーパがつけられている不揮発性半導体記憶装置。